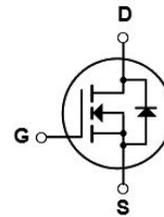
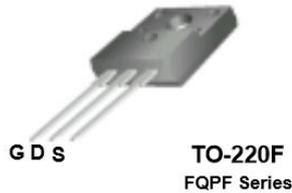


MOSFET CANAL N 700V/5.8A

Número de parte: FQPF12N70



Descripción:

El MOSFET de potencia es un producto de la evolución de la tecnología CMOS, originalmente desarrollada para la fabricación de circuitos integrados. Desde su introducción al mercado a comienzos de la década de 1980, los MOSFET de potencia han ido evolucionando en su estructura funcional hasta alcanzar su madurez definitiva con el proceso de doble difusión (DMOS), también llamado de difusión vertical (VDMOS). Esa tecnología avanzada ha sido especialmente adaptada a minimizar la resistencia en el estado, proporcionar rendimiento de conmutación, soportar pulsos de alta energía en el avalancha y el modo de conmutación. Estos dispositivos son adecuados para una alta eficiencia en fuentes de alimentación conmutada.

Características:

Polaridad del transistor: Canal-N.

Tensión D-S: 600V Típicos.

Corriente D -Continua (Tc = 25°C): 5.8A.

-Continua (Tc = 100°C): 3.7A.

Tensión G-S: $\pm 30V$.

Corriente de Avalancha: 5.8A.

	AG Electrónica S.A. de C.V. República del Salvador N° 20 Segundo Piso Teléfono: 5130 - 7210		
Acotación: NA	http://www.agelectronica.com/	Escala NA	Rev 1. BMF Rev 2.
Tolerancia: NA	MOSFET CANAL N 700V/5.8A		
Tolerancia: NA	Fecha: 21/01/2016	Número de parte: FQPF12N70	